

Испытательный центр ОАО «РНИИ «Электронстандарт», 196084, Санкт –Петербург, ул. Цветочная, 25, корп.3,
№ СВС.01.622.0142.12 Тел. (812) 676-28-92, факс (812) 676-28-96, E-mail: malinin@elstandart.spb.ru

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела №2 137 ВП МО РФ

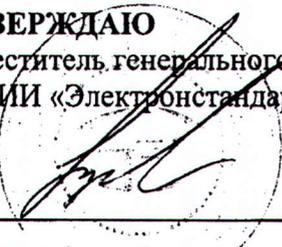


А.А. Максимычев

« 30 » 04 2012 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора ОАО
«РНИИ «Электронстандарт», директор ИЦ



В.Г. Малинин

« 27 » 04 2012 г.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ №ЭС – КПЕИ-152
на интегральные микросхемы ADM706ARZ**

Санкт-Петербург
2012г.

Настоящая техническая спецификация (ТС) распространяется на интегральные микросхемы ADM706ARZ (далее ИС), выпускаемые фирмой Analog Devices соответствующие требованиям данной спецификации, предназначенные для работы в аппаратуре

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 ТС составлена на основе спецификации фирмы-изготовителя Analog Devices и результатов сертификационных испытаний в ИЦ ОАО «РНИИ «Электронстандарт» по программе: «Проведения сертификационных испытаний ЭРИ иностранного производства, используемых для комплектования изделий, предназначенных для применения в составе изделия

1.2 ТС составлена для ИС, относящихся к партии с датой изготовления 01 неделя 2011г.

1.3 Термины, определения и обозначения параметров ИС соответствуют обозначениям спецификации D00088-0-3/08(G) фирмы – изготовителя Analog Devices.

1.4 Условное обозначение микросхем при заказе и в конструкторской документации аппаратуры:

Микросхемы ADM 706 A R Z, где:
 1 2 3 4 5

- 1 - префикс фирмы-изготовителя Analog Devices
- 2 - тип интегральной микросхемы (706)
- 3 - диапазон рабочей температуры (-40°С ÷ +85°С)
- 4 - тип корпуса: 8-Lead SOIC
- 5 - выполнение в соответствии с требованиями RoHS

1.5. Состав покрытия выводов

Покрытие выводов интегральных микросхем ADM706ARZ с датой изготовления 01 неделя 2011г. состоит из элементов в соотношении: Sn-99%, Cu-1%., выполненных в соответствии с требованиями RoHS

1.6. Влагозащищенность – ИС соответствуют уровню чувствительности к влажности (Moisture Sensitivity Level, MSL) MSL - 1.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Спецификация фирмы-изготовителя Analog Devices, на микросхемы ADM706	D00088-0-3/08(G)
ГОСТ РВ 20.39.412-97	Комплексная система ОТТ. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические военного назначения. Общие технические требования
ГОСТ РВ 20.39.414.1-97	Комплексная система ОТТ. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические военного назначения. Классификация по условиям применения и требования стойкости к внешним воздействующим факторам
ГОСТ РВ 20. 57.414-97	КСКК. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические военного назначения. Методы оценки соответствия требованиям к надежности
ГОСТ РВ 20.57.415-98	КСКК. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические военного назначения. Методы оценки соответствия требованиям стойкости к воздействию ионизирующих и электромагнитных излучений
ГОСТ РВ 20.57.416-98	КСКК. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические военного назначения.

	Методы испытаний
ГОСТ В9.003 - 80	Военная техника. Общие требования к условиям хранения
ГОСТ 23088 -80	Изделия электронной техники. Требования к упаковке, транспортированию и методы испытания.
ОСТ 11 073.013-83	Микросхемы интегральные. Методы испытаний
ОСТ В 11 0998-99	Микросхемы интегральные. Общие технические условия.
ОСТ 11 14.1012-99	Микросхемы интегральные. Технические требования к технологическому процессу. Система и методы операционного контроля.
ОСТ 11 094.029-73	Изделия электронной техники. Контроль неразрушающий. Методы рентгенотелевизионной микроскопии
ГОСТ 18353-79	Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов

3. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ

Для интегральных микросхем ADM706ARZ проведен 100% визуальный контроль. Внешний вид изделий соответствует чертежу спецификации D00088-0-3/08(G)

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Классификация, основные параметры

4.1.1 Данные фирмы-изготовителя по основным параметрам микросхемы ADM706ARZ, приведены в таблице 1.

Таблица 1

Номер параметра	Наименование параметра. Единица измерения.	Буквенное обозначение	Норма			Номинальный режим
			не менее	номинал	не более	
1.	Ток потребления, мкА	I_{CC}		190	250	$V_{CC} = 4,75 \dots 5,5 \text{ В}$
2.	Пороговое напряжение, В	V_{RT}	4,25	4,4	4,5	
3.	Выходное напряжение высокого уровня (RESET), В	V_{OH}	$V_{CC} - 1,5 \text{ В}$			$4,5 \text{ В} < V_{CC} < 5,5 \text{ В}$ $I_{SOURCE} = 800 \text{ мкА}$
4.	Выходное напряжение низкого уровня (RESET), В	V_{OL}			0,4	$4,5 \text{ В} < V_{CC} < 5,5 \text{ В}$ $I_{SINK} = 3,2 \text{ мА}$
5.	Длительность импульса RESET, мс		160	200	280	
6.	Длительность импульса WDI, нс		50			$4,5 \text{ В} < V_{CC} < 5,5 \text{ В}$
7.	Входной ток (WDI), мкА			50	150	$WDI = V_{CC}$
8.			-150	-50		$WDI = 0 \text{ В}$
9.	Выходное напряжение высокого уровня (nWDO), В	V_{OH}	$V_{CC} - 1,5 \text{ В}$			$4,5 \text{ В} < V_{CC} < 5,5 \text{ В}$ $I_{SOURCE} = 800 \text{ мкА}$
10.	Выходное напряжение низкого уровня (nWDO), В	V_{OL}			0,4	$4,5 \text{ В} < V_{CC} < 5,5 \text{ В}$ $I_{SINK} = 1,2 \text{ мА}$
11.	Входной ток (MR), мкА		100	250	600	$4,5 \text{ В} < V_{CC} < 5,5 \text{ В}$
12.	Длительность импульса MR, нс		150			$4,5 \text{ В} < V_{CC} < 5,5 \text{ В}$
13.	Время задержки распространения от MR к RESET, нс				250	$4,5 \text{ В} < V_{CC} < 5,5 \text{ В}$
14.	Входное пороговое напряжение (PFI), В		1,2	1,25	1,3	
15.	Входной ток (PFI), нА		-25	0,01	25	

Номер параметра	Наименование параметра. Единица измерения.	Буквенное обозначение	Норма			Номинальный режим
			не менее	номинал	не более	
16.	Выходное напряжение высокого уровня (PFO), В	V_{OH}	$V_{CC} - 1,5 В$			$4,5 В < V_{CC} < 5,5 В$ $I_{SOURCE} = 800 мкА$
17.	Выходное напряжение низкого уровня (PFO), В	V_{OL}			0,4	$4,5 В < V_{CC} < 5,5 В$ $I_{SINK} = 3,2 мА$

4.2 Требования по назначению

Микросхемы ADM706ARZ представляет собой супервизор 5-ти вольтового питания с контролем функционирования микропроцессора. Поставляется в корпусе SOIC, 8-ми выводной. Диапазон рабочих температур $-40^{\circ}C \div +85^{\circ}C$.

Данная микросхема предназначена для контроля напряжения питания в микропроцессорных системах, микроконтроллерах, автомобильной промышленности

4.3. Требования по надежности

4.3.1. Интегральные микросхемы ADM706ARZ с датой изготовления 01 неделя 2011г. удовлетворяют требованиям по надежности с параметрами, указанными в таблице 2

Таблица 2

Срок активного функционирования аппаратуры, час	
Срок сохраняемости, лет	

4.4 Требования по стойкости к внешним воздействующим факторам

4.4.1. Интегральные микросхемы ADM706ARZ с датой изготовления 01 неделя. 2011г. являются стойкими к внешним воздействующим факторам, указанным в таблице 3

Таблица 3

Наименование ВВФ	Наименование характеристик ВВФ, единица измерения	Значение воздействующего фактора
1. Повышенная температура	Предельная, $^{\circ}C$	
	Рабочая, $^{\circ}C$	
2. Пониженная температура	Предельная, $^{\circ}C$	
	Рабочая, $^{\circ}C$	
3. Изменение температуры среды	Диапазон изменения температуры, $^{\circ}C$ (не более $3^{\circ}C$ в минуту)	
4. Повышенная влажность воздуха	Относительная влажность при температуре: $+5...+28^{\circ}C$ $+20^{\circ}C$	
5. Атмосферное пониженное давление	Па мм рт.ст.	
6. Атмосферное повышенное давление	Па мм рт.ст.	
7. Линейное ускорение	Амплитуда линейного ускорения, g	
	Продолжительность воздействия, мин.	
8. Ударно-импульсные нагрузки	Ударный спектр, g	
	Частота, Гц	
	Количество ударов	
9. Акустическое воздействие	Диапазон частот, Гц	

Наименование ВВФ	Наименование характеристик ВВФ, единица измерения	Значение воздействующего фактора
	Уровень звукового давления, дБ	
	Продолжительность воздействия, с	
10. Установившиеся вибрационные воздействия	Диапазон частот, Гц	
	Амплитуда ускорения, g	
	Продолжительность воздействия, с	
11. Случайные стационарные вибрационные воздействия	СПМ, $g^2/Гц$	
	Частота, Гц	
	Продолжительность, с	
12. Спец. виды воздействия	Электроны, поглощенная доза, рад.	
	Протоны, поглощенная доза, рад.	
	Протоны, макс. Мощность погл. дозы, рад/с	
	Суммарная поглощенная доза, рад	
13. ЭМИ	Напряжение зажигания разрядного импульса, кВ	
	Максимальный ток в разрядном импульсе, А	
	Энергия в разрядном импульсе, Дж	
	Длительность разрядного импульса тока, с	
	Длит. Фронта разрядного импульса тока, с	
	Частота разрядов, Гц	
14. Электрическое поле	Напряженность, кВ/м	

4.4.2. Микросхемы являются пожаробезопасными.

4.5. Конструктивные требования

Габарит, чертеж корпуса микросхемы ADM706ARZ показан на рис. 1. Размеры указаны в миллиметрах, в скобках дюймы.

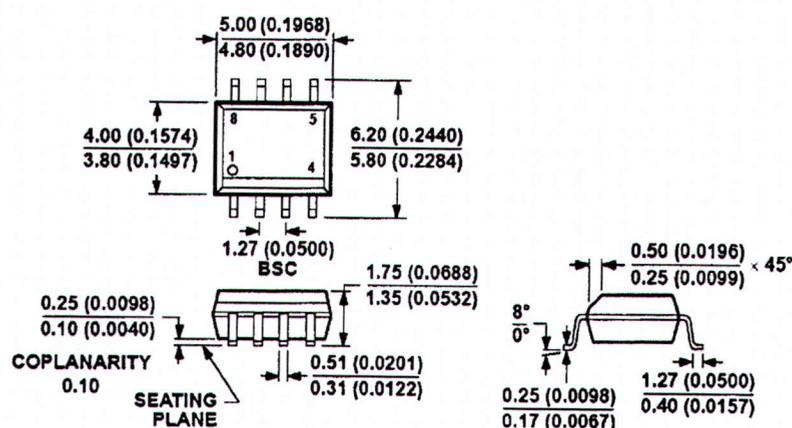


Рис. 1

4.6. Требования по маркировке (дополнительной)

Интегральные микросхемы ADM706ARZ, прошедшие сертификационные испытания в испытательном центре ОАО «РНИИ «Электронстандарт» и признанные соответствующими требованиям эксплуатационной модели на изделие маркируются посредством нанесения знака отличительной маркировки в виде одной белой точки. На потребительскую

тару и сопроводительные документы наносится отличительный символ испытательного центра «У».

5. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И ПОСТАВКИ

5.1. Партия ИС, поступившая для проведения сертификационных испытаний, подвергается 100% входному контролю, 100% отбраковочным испытаниям и выборочному РФА. Перечень контролируемых электрических параметров и режимы измерений указаны в разделе 6.

5.2. В состав партии ИС входят образцы изделий одного изготовителя, одной даты изготовления.

5.3. Суммарный допустимый процент отбраковки (ДПО) по результатам входного контроля и отбраковочных испытаний равен 10%.

5.4. Выборочный разрушающий физический анализ проводится на представительной выборке от партии изделий. Количество образцов для РФА устанавливается в соответствии с методами анализа, регламентированными ОСТ 11 073.013-83, ОСТ В 11 0998-99, ОСТ 11 14.1012-97 и разработанными ИЦ ОАО «РНИИ «Электронстандарт» методиками. Приемочное число РФА - $c = 0$. В случае несоответствия изделий требованиям ОСТ 11 073.013-83, ОСТ В 11 0998-99, ОСТ 11 14.1012-97 проводятся повторные испытания: 100% входной контроль; 100% отбраковочные испытания и выборочный физический анализ новой партии.

5.5. Приемочное число сертификационных испытаний $c = 0$. В случае, если $c \neq 0$ проводятся повторные испытания на выборке новой партии ИС.

5.6. Изделия поставляются потребителю со свидетельством о прохождении испытаний

6. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

6.1. Методы и режимы испытаний на ВВФ устанавливаются в соответствии с ГОСТ РВ 20 57.416-98.

6.2 Испытания на воздействие спецфакторов проводят соответственно по ГОСТ РВ 20 57.415-98.

6.3 Испытания на соответствие требованиям к надежности проводят по ГОСТ РВ 20.57.414-97

6.4. Электрические параметры-критерии, подлежащих контролю при приемке и поставке, приведены в табл. 4.

Таблица 4

Номер параметра	Наименование параметра. Единица измерения.	Буквенное обозначение	Норма			Режим измерения	Температура, °С
			не менее	номинал	не более		
1	Ток потребления, мкА	I_{CC}		190	250	$V_{CC} = 4,75 \div 5,5 \text{ В}$	25 ± 10
2	Пороговое напряжение, В	V_{RT}	4,25	4,4	4,5		"-
3	Выходное напряжение высокого уровня (RESET), В	V_{OH}	$V_{CC} - 1,5 \text{ В}$			$4,5 \text{ В} < V_{CC} < 5,5 \text{ В}$ $I_{SOURCE} = 800 \text{ мкА}$	"-
4	Выходное напряжение низкого уровня (RESET), В	V_{OL}			0,4	$4,5 \text{ В} < V_{CC} < 5,5 \text{ В}$ $I_{SINK} = 3,2 \text{ мА}$	"-

Номер параметра	Наименование параметра. Единица измерения.	Буквенное обозначение	Норма			Режим измерения	Температура, °C
			не менее	номинал	не более		
5	Длительность импульса RESET, мс		160	200	280		"-
6	Выходное напряжение высокого уровня (nWDO), В	V _{OH}	V _{CC} - 1,5 В			4,5 В < V _{CC} < 5,5 В I _{SOURCE} = 800 мкА	"-
7	Выходное напряжение низкого уровня (nWDO), В	V _{OL}			0,4	4,5 В < V _{CC} < 5,5 В I _{SINK} = 1,2 мА	"-
8	Входной ток (MR), мкА		100	250	600	4,5 В < V _{CC} < 5,5 В	"-
9	Входной ток (PFI), нА		-25	0,01	25		"-

6.5. Состав и последовательность испытаний на соответствие требованиям заказчика с учетом эксплуатационной модели указан в таблице 5.

Таблица 5

№ группы испытаний	Номер испытаний Вид и последовательность испытаний	п-объем образцов в выборке, шт.; с - приемочное число	Метод и режимы испытаний по ГОСТ РВ 20.57.416-98 с учетом НД на отечественные аналоги изделий	Примечания	
1. Входной контроль и отбраковочные испытания					
S0	1. Проверка внешнего вида, идентификация	100% поставляемой партии	405-1	Идентификация продукции проводится в соответствии с ГОСТ Р 51293-99.	
	2. Проверка габаритных, установочных и присоединительных размеров		404-1		
	3. Определение массы изделия		406-1		
	4. Проведение параметрического и функционального контроля при НКУ			T = () °C φ = () % P = () мм рт.ст.	Контролируемые параметры и их нормы приведены в таблице 4.
	5. Оценка параметров по ужесточенным нормам			методика контроля электрических параметров по ужесточенным нормам (ИЦ 781.00.115 М)	
	6. Электротермотренировка			201-1 T= С, время выдержки часа	
	7. Испытание на воздействие изменения температуры среды			205-1	Температура из спецификации завода-изготовителя.
	8. Проведение параметрического и функционального контроля при НКУ			T = () °C φ = () % P = () мм рт.ст.	Контролируемые параметры и их нормы приведены в таблице 4.
	9. Оценка параметров по ужесточенным нормам			методика контроля электрических	

№ группы испытаний	Номер испытаний Вид и последовательность испытаний	п-объем образцов в выборке, шт.; с - приемочное число	Метод и режимы испытаний по ГОСТ РВ 20.57.416-98 с учетом НД на отечественные аналоги изделий	Примечания
	10. Оценка дрейфа параметров после ЭТТ, УН		параметров по ужесточенным нормам (ИЦ 781.00.115 М) методика контроля дрейфа параметров ЭРИ после ЭТТ (ИЦ 781.00.100М)	
2. Сертификационные испытания				
S1	11. Определение собственной резонансной частоты конструкции изделий	n =	100-1.1 диапазон частот, Гц	
S2	12. Испытание на воздействие синусоидальной вибрации (вибропрочность)	n= , c =	103-1.1 диапазон частот F = Гц j = g продолжительность испытаний t = мин. по осям X, Y, Z	
	13. Испытание на ударную прочность при воздействии механического удара одиночного действия		106-1 j = g τ = мс удара по осям X, Y, Z	
	14. Испытание на воздействие изменения температуры среды		205-2 от минус °С до + °С; к-во циклов - ; продолжительность одного цикла - час; скорость изменения температуры не более °С/мин	
	15. Измерение электрических параметров и функциональный контроль в НКУ		T = () °С φ = () % P = (645÷795) мм рт.ст.	Контролируемые параметры и их нормы приведены в таблице 4.
S3	16. Испытание на воздействие повышенной температуры среды	n= , c =		
	- повышенная рабочая температура		201-2.1 T _{вр} = °С t = мин.	
	- повышенная предельная температура		202 T _{вп} = °С t = мин.	
	17. Испытания на воздействие повышенной влажности воздуха	n= , c =	207-2 T = °С φ = () %; t = суток	
	18. Испытание на воздействие пониженной температуры среды			
	- пониженная рабочая температура		203 T _{нр} = °С t = мин.	
	- пониженная предельная температура		204 T _{нп} = минус °С t = мин.	
19. Измерение электрических параметров и функциональ-			T = () °С φ = () %	Контролируемые параметры и их нормы приведены в

№ группы испытаний	Номер испытаний Вид и последовательность испытаний	n-объем образцов в выборке, шт.; с - приемочное число	Метод и режимы испытаний по ГОСТ РВ 20.57.416-98 с учетом НД на отечественные аналоги изделий	Примечания
	ный контроль в НКУ		P=() мм рт.ст.	таблице 4.
S4	20. Испытание на воздействие пониженного атмосферного давления	n= , c =	209-1 P = мм рт. ст.	
	21. Испытания на воздействие повышенного атмосферного давления		210-1 P = мм. рт. ст.	
	22. Испытание на акустическое воздействие		108-2 P = дБ f = Гц t = сек.	
	23. Измерение электрических параметров и функциональный контроль в НКУ		T= ()°C φ = ()% P=() мм рт.ст.	Контролируемые параметры и их нормы приведены в таблице 4.
S5	24. Испытание на способность к пайке	n = , c =	Изделие выполнено по технологии «Pb-free», испытание на способность к пайке не проводилось	
	25. Испытание на пожарную безопасность (горючесть)		409-1 время приложения пламени с	
S6	26. Испытания на воздействия электромагнитного импульса (ЭМИ)		ГОСТ РВ 20.39.308-98	Испытания на воздействие ЭМИ проводятся по отдельным программам, утверждаемым филиалом ФБУ «46 ЦНИИ Минобороны России»
S7	27. Испытания на воздействия электрического поля		ГОСТ РВ 20.39.308-98, напряженность кВ/м	Испытания на воздействие эл поля проводятся по отдельным программам, утверждаемым филиалом ФБУ «46 ЦНИИ Минобороны России»
S8	28. Испытания на спецвоздействия	Испытания на воздействие спецфакторов проводятся по отдельным программам, утверждаемым филиалом ФБУ «46 ЦНИИ Минобороны России»		
S9	29. Ускоренные испытания на безотказность	Ускоренные испытания на безотказность в целях определения соответствия ЭРИ ИП требованиям по наработке до отказа (часов) проводятся по отдельной программе оценки показателей надежности всей номенклатуры ЭРИ ИП, согласованной с филиалом ФБУ «46 ЦНИИ Минобороны России».		
S10	30. Ускоренные испытания на сохраняемость	Ускоренные испытания в целях определения соответствия ЭРИ ИП требованиям по сохраняемости (срок сохраняемости лет) проводятся по отдельной программе оценки показателей надежности всей номенклатуры ЭРИ ИП, согласованной с филиалом ФБУ «46 ЦНИИ Минобороны России».		

6.6. В соответствии с п. 4.30 ГОСТ РВ 20.57.416-98 испытания на воздействие гармонической вибрации на частотах ниже 10 Гц не проводят, если низшая резонансная частота изделия превышает 25 Гц.

6.7. В соответствии с п. 4.32 ГОСТ РВ 20.57.416-98 изделия, имеющие менее 4-х резонансных частот, допускается подвергать испытаниям на воздействие гармонической (синусоидальной) вибрации взамен широкополосной случайной вибрации.

6.8. Испытание на воздействие линейного ускорения не проводится, т.к. в соответствии с п. 4.37 ГОСТ РВ 20.57.416-98 данное испытание допускается не проводить, если в Программе испытаний предусмотрены испытания на воздействия одиночных или многократных ударов с уровнем ускорения, равным или превышающим значение линейного ускорения, указанного в требованиях.

7. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

7.1 Упаковка изделий соответствует требованиям ГОСТ РВ 20.39.412-97 и ГОСТ

23088-80.

7.2 Упаковка изделий обеспечивает защиту от статического электричества и магнитных полей (для изделий, чувствительных к электростатическому разряду), а также от механических воздействий при транспортировании.

8. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

8.1. Транспортирование и хранение в соответствии с требованиями ГОСТ23088-80 и ОСТ В11 0998-99.

По уровню чувствительности к влажности интегральные микросхемы ADM706ARZ соответствуют уровню 1. Требования к хранению изделий уровня MSL 1 приведены в таблице 6.

Таблица 6

Уровень MSL	Безопасное время после вскрытия защитного пакета («floor life»)	
	Время	Условия хранения
1	не ограничено	$\leq 30^{\circ}\text{C}/85\%$

9. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (порядок обращения)

9.1. Применение

Общие указания – ОСТ В 11 0998-99.

Микросхемы чувствительны к СЭ. При проведении монтажа и регулировки аппаратуры необходимо принимать меры по защите от статического электричества в соответствии с ОСТ 11 073.062-2001.

При монтаже микросхем скорректировать технологию пайки на основе рекомендаций фирмы-производителя для изделий с покрытием выводов категории E2

Рекомендации стандарта JEDES J-STD-020D.1 по параметрам и режимам при пайке изделий выполненных в соответствии с требованиями RoHS.

В соответствии с указанным стандартом рекомендуются следующие максимальные температуры корпуса ИС для поверхностного монтажа, которые приведены в табл.7

Таблица 7

Толщина корпуса, мм	Объем корпуса, мм ³
	Температура, град. °C
	°C

Параметры обобщенного температурного профиля даны на рис.2 и приведены в таблице 8

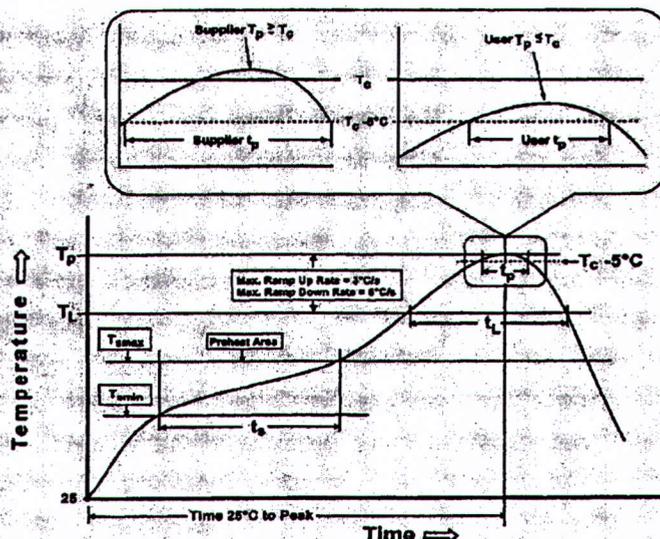


Рис.2

Таблица 8

Параметры профиля	Значения параметров профиля
Предварительный нагрев	
Минимальная температура T_{smin}	°C
Максимальная температура T_{smax}	°C
Время t_s от T_{smin} до T_{smax}	с
Скорость нагрева в диапазоне от T_L до T_P	град/с
Температура плавления T_L	°C
Время области t_L	с
Максимальная пиковая температура T_P	Указана в таблице 7
Время пайки при T_P минус °C	с
Скорость остывания в диапазоне от T_L до T_P	град/с
Время нагрева от °C до T_P	мин. max

Примечание: значения температур соответствует температуре корпуса изделия. Символом T_C

Допустимое количество исправлений дефектов пайки отдельных выводов не более - двух.

Способ установки микросхем на платы должен обеспечивать отсутствие усилий, деформирующих корпус.

При эксплуатации, в том числе в момент включения, при переходных процессах, при изменении режимов работы должны быть приняты меры:

- по исключению подачи напряжения питания при неподключенных (находящихся в отрыве) входах микросхем;
- по исключению подачи входных напряжений при отсутствии напряжения питания на выводах микросхем.

9.2. Расположение и обозначение выводов

Расположение и обозначение выводов микросхемы ADM706ARZ показаны на рис.3.

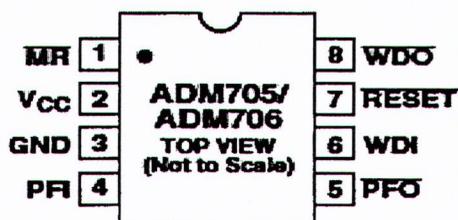


Рис.3

Расшифровка функционального назначения выводов указана в таблице 9

Таблица 9

Номер вывода	Обозначение выводов	Функциональное назначение
1.	#MR	Сброс
2.	V _{CC}	Питание
3.	GND	Земля
4.	PFI	Вход контролирующего устройства
5.	#PFO	Выход контролирующего устройства
6.	WDI	Вход «сторожевого» устройства
7.	#RESET	выход
8.	#WDO	Выход «сторожевого» устройства

10. Порядок ведения рекламационной работы

Порядок ведения рекламационной работы определен требованиями ГОСТ РВ 15.703-2005 «Военная техника. Порядок предъявления и удовлетворения рекламаций».

При выявлении несоответствия ЭРИ ИП установленным требованиям в процессе входного контроля, монтажа и испытаний узлов, блоков РЭА или аппаратуры в целом на предприятии потребителе ЭРИ бракуются и возвращаются поставщику

с предъявлением рекламации в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.703-2005.
Поставщик – организует проведение технической экспертизы забракованных партий.

Начальник группы отдела №2 137 ВП МО РФ
А.А.Тюмин

« 30 » 04 2012г.

Начальник отдела
ОАО «РНИИ «Электронстандарт»
А.С.Захаров

« 19 » 04 2012г.

Начальник отдела
ОАО «РНИИ «Электронстандарт»
Е.В.Митин

« 19 » 04 2012г.